

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

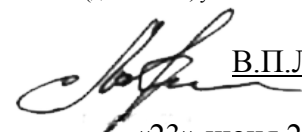
Кафедра конструирования и технологий электронных и лазерных средств (№23)

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель направления

проф., д.т.н., проф.

(должность, уч. степень, звание)

 В.П.Ларин

«23» июня 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Технологии обработки концентрированными потоками энергии»
(Наименование дисциплины)

Код направления подготовки/ специальности	11.03.03
Наименование направления подготовки/ специальности	Конструирование и технология электронных средств
Наименование направленности	Проектирование и технология электронно- вычислительных средств
Форма обучения	очная

Санкт-Петербург 2021

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил:

проф., д.т.н., проф.
(должность, уч. степень, звание)


(подпись, дата)

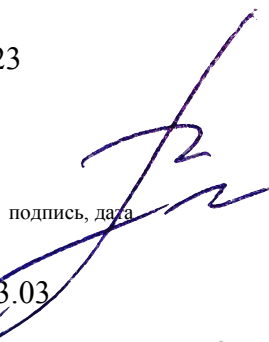
В.П. Ларин
(инициалы, фамилия)

Программа одобрена на заседании кафедры № 23

«17 мая 2021 г., протокол № 9/21

Заведующий кафедрой № 23

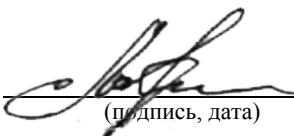
д.т.н., проф.
должность, уч. степень, звание


подпись, дата

А.Р. Бестугин
инициалы, фамилия

Ответственный за ОП 11.03.03


проф., д.т.н., проф.
(должность, уч. степень, звание)


(подпись, дата)

В.П. Ларин
(инициалы, фамилия)

Заместитель директора института №2 по методической работе

доц., к.т.н., доц.
(должность, уч. степень, звание)


(подпись, дата)

О.Л. Бальшева
(инициалы, фамилия)

Аннотация

Дисциплина «Технологии обработки концентрированными потоками энергии» входит в образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ специальности 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств » направленности «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств». Дисциплина реализуется кафедрой «№23».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

ПК-10 «Готов выполнять проектирование устройств микроэлектроники и разрабатывать технологию их изготовления»

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами и средствами обработки материалов концентрированными потоками энергии. Дисциплина относится к формированию компетенций, связанных с производственно-технологическим видом профессиональной деятельности выпускника.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

Язык обучения по дисциплине «русский»

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.1. Цели преподавания дисциплины

Цель дисциплины связана с технологической подготовкой в области освоения методов и средств обработки материалов концентрированными потоками энергии. Дисциплина относится к формированию компетенций, относящихся к производственно-технологическому виду профессиональной деятельности выпускника, предусмотренному образовательным стандартом..

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО).

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения

Категория (группа) компетенции	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональные компетенции	ПК-10 Готов выполнять проектирование устройств микроэлектроники и разрабатывать технологию их изготовления	ПК-10.3.1 знает основные требования к вспомогательным устройствам (блокам питания, индикаторам, контрольным устройствам), механические и климатические требования, эксплуатационные требований, требований к серийно способности, надежности и другим показателям ПК-10.У.1 умеет формулировать цели и задачи проектирования электронного и микроэлектронного устройства или системы, разрабатывать техническое задание на проектирование ПК-10.В.1 владеет навыками выбора оптимальных проектных решений на всех этапах от технического задания до производства микроэлектронных изделий

В результате изучения дисциплины студент должен **знать:**

- методы обработки материалов при изготовлении деталей концентрированными потоками энергии;
- средства, применяемые для обработки различными видами энергии;
- физико-химические процессы, происходящие при обработке материалов концентрированными потоками энергии;

студент должен **уметь:**

- выбирать соответствующий вид технологии обработки материалов концентрированными потоками энергии для достижения совершенствования и развития способов получения новых свойств ЭС;
- проектировать ТП и комплексы для обработки материалов концентрированными потоками энергии;

студент должен **владеть:**

- методиками расчета параметров ТП обработки материалов концентрированными потоками энергии;
- методиками расчета технико-экономической эффективности применения процессов обработки материалов концентрированными потоками энергии;
- методиками осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов ТП и технической документации по процессам и комплексам стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами при изучении следующих дисциплин: «Физика», «Химия», «Материаловедение», «Технология конструкционных материалов», «Электроника».

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: «Физико-химические основы технологии ЭС», «Технология производства ЭС», «Основы автоматизации ТП».

3. Объем и трудоемкость дисциплины

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего	Трудоемкость по семестрам
		№5
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час)	5/ 180	5/ 180
Из них часов практической подготовки	34	34
Аудиторные занятия, всего час.	68	68
в том числе:		
лекции (Л), (час)	34	34
лабораторные работы (ЛР), (час)	34	34
экзамен, (час)	54	54
Самостоятельная работа, всего (час)	58	58
Вид промежуточной аттестации: зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**)	Экз.	Экз.

4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий.

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость

Разделы, темы дисциплины	Лекции (час)	ПЗ (СЗ) (час)	ЛР (час)	КП (час)	СРС (час)
Семестр 5					
Раздел 1. Термодинамический и молекулярно-атомарный подход к описанию технологических процессов.	6		4		12
Раздел 2. Физико-химические основы процессов удаления пленок с поверхности твердого тела.	4		6		12
Раздел 3. Физико-химические основы процессов образования новой фазы на поверхности твердого тела.	6		4		10
Раздел 4. Электрофизические и электрохимические методы формообразования деталей приборостроения.	8		8		10
Раздел 5. Физико-химические основы процессов лазерной, фотонной и электронно-лучевой обработки материалов.	10		8		12
Итого в семестре:	34		34		58
Итого	34	0	34	0	58

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий.

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла

Название и содержание разделов и тем лекционных занятий
<p>Раздел 1. Термодинамический и молекулярно-атомарный подход к описанию технологических процессов.</p> <p><i>Тема 1.1 - Технологический процесс как термодинамическая система. Внутренняя энергия системы. Параметры состояния системы. Описание параметров, их взаимосвязь и взаимозависимость</i></p> <p><i>Тема 1.2 - Молекулярно-атомарный подход к описанию технологических процессов. Кинетика технологических процессов. Поток, как основная кинетическая характеристика системы. Характеристики потока. Константа скорости реакции. Энергия активации.</i></p>
<p>Раздел 2. Физико-химические основы процессов удаления пленок с поверхности твердого тела.</p> <p><i>Тема 2.1 Физико-химические основы поверхностных процессов. Термодинамика чистой поверхности. Поверхностное натяжение. Смачивание. Методы определения поверхностного натяжения. Поверхностно-активные вещества. Закономерности и природа адгезии. Адгезионные структуры.</i></p> <p><i>Тема 2.2 Закономерности травления. Скорость травления. Энергия активации. Анизотропное травление, селективное травление, локальное травление. Термодинамика анизотропного травления. Возможности анизотропного травления.</i></p> <p><i>Тема 2.3 Физическое, ионное, плазмохимическое травление.</i></p>
<p>Раздел 3. Физико-химические основы процессов образования новой фазы на поверхности твердого тела.</p> <p><i>Тема 3.1 Термодинамика образования зародышей пленки. Критический радиус и критическая энергия зародыша. Способы образования критических и закритических зародышей. Теория Гиббса. Теория Френкеля.</i></p> <p><i>Тема 3.2 Понятие эпитаксии. Гомоэпитаксия и гетероэпитаксия. Эпитаксия из паровой, газовой и жидкой фазы. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Механизм формирования гетероэпитаксиальных структур методом МЛЭ.</i></p> <p><i>Тема 3.3 Эпитаксия из газовой фазы. Хлоридный и силановый методы.</i></p> <p><i>Тема 3.4. Эпитаксия из жидкой фазы бинарных полупроводников.</i></p> <p><i>Тема 3.5 Физико-химические основы термовакуумного испарения и осаждения материалов. Испарение чистых металлов в вакууме. Механизм испарения. Температура испарения, скорость испарения. Испарение сплавов и химических соединений. Электронно-лучевые и лазерные методы испарения. Кинетика и механизм осаждения.</i></p> <p><i>Тема 3.6 Физико-химические основы ионных, ионно-плазменных, плазмохимических методов нанесения пленок. Аномальный тлеющий разряд. Элементы импульсной теории ионного распыления. Коэффициент ионного распыления и его зависимость от материала мишени. Катодное распыление. Плазмо-химическое и магнетронное осаждение. Кинетика и механизм осаждения.</i></p>
<p>Раздел 4. Электрофизические и электрохимические методы формообразования деталей приборостроения.</p> <p><i>Тема 4. 1 Физико-математические основы процессов диффузии. Поток, как основная кинетическая характеристика системы. Характеристики потока. Источники и стоки системы, основы кинетики процессов. Законы Фика. Механизмы диффузии. Кинетика диффузии. Решения уравнения диффузии. Диффузия из ограниченного и неограниченного источников.</i></p> <p><i>Тема 4.2 Физические основы ионной имплантации. Распределение примесей и пробега ионов при внедрении в аморфную мишень. Распределение пробега ионов в монокристаллических подложках. Эффект каналирования. Аморфизация и рекристаллизация кремния после имплантации.</i></p>
<p>Раздел 5. Физико-химические основы процессов лазерной, фотонной и электронно-лучевой обработки материалов.</p> <p><i>Тема 5.1 Фотохимическое воздействие на вещество. Основные законы фотохимии. Основные типы фотохимических реакций. Квантовый выход. Воздействие актиничного излучения на</i></p>

чувствительные материалы. Фоторезисты, рентгенорезисты, электронорезисты, ионорезисты.
 Тема 5.2 Фотохимические и физико-химические процессы получения скрытого и видимого изображения. Свойства фоторезистов. Светочувствительность, разрешающая способность фоторезистов.
 Тема 5.3 Негативные фоторезисты. Позитивные фоторезисты. Физико-химическая сущность процессов нанесения, экспонирования, проявления. Растворители, проявители. Контрастность, стойкость к последующим технологическим воздействиям. Методы термообработки, удаления, механизм удаления.
 Тема 5.4 Контактная и проекционная микролитографии, их разновидности. Фотошаблоны, рентгеношаблоны, электрошаблоны, ионошаблоны.

4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость

№ п/п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено					
Всего					

4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, (час)	№ разд
1	Исследование распределения удельного поверхностного сопротивления резистивной пленки	4	4
2	Исследование процесса термовакуумного напыления	4	4
3	Исследование процесса диффузии примеси в полупроводник из постоянного источника	6	4
4	Исследование и оптимизация параметров сварки элементов интегральных микросхем	4	5
5	Моделирование и исследование технологического процесса электроэрозионной обработки	8	5
6	Исследование процессов обработки с применением лазеров	8	5
Всего:		34	

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы

Учебным планом не предусмотрено

4.6. Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

Вид самостоятельной работы	Всего, час	Семестр 5, час
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	20	20
Подготовка к текущему контролю	1	1
Подготовка к лабораторным занятиям	37	37
Всего	58	58

5. Перечень учебно-методического обеспечения

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 7-11.

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8.

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий

Шифр/ URL адрес	Библиографическая ссылка	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
538.9.Б 26	В.И.Томилин. Физико-химические основы технологии ЭС. Учебник. Серия: Высшее профессиональное образование. Академия, 2010. 416с.	20
621.38(075) С 50	Смирнов, В. И. Физико-химические основы технологии электронных средств: учебное пособие / В. И. Смирнов. - Ульяновск: УлГТУ, 2005.- 112 с.	10

7. Перечень электронных образовательных ресурсов

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

URL адрес	Наименование

8. Перечень информационных технологий

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10– Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование
	Не предусмотрено

8.2. Перечень информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем

№ п/п	Наименование
http://lib.aanet.ru/	Доступ в ЭБС «Лань» осуществляется по договору № 27, №28 от 27.01.2021 Доступ в ЭБС «ZNANIUM» осуществляется по договору № 071 от 24.02.2021 Доступ в ЭБС «ЮРАЙТ» осуществляется по договору № 070 от 24.02.2021

9. Материально-техническая база

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

№ п/п	Наименование составной части материально-технической базы	Номер аудитории
1	Мультимедийная лекционная аудитория	14-06Г
3	Специализированная лаборатория	14-06В

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

10.1. Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Перечень оценочных средств
Экзамен	Список вопросов к экзамену;

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП.

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Оценка компетенции	Характеристика сформированных компетенций
5-балльная шкала	
«отлично» «зачтено»	– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал; – уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; – опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления; – умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; – делает выводы и обобщения; – свободно владеет системой специализированных понятий.
«хорошо» «зачтено»	– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; – не допускает существенных неточностей; – увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления; – аргументирует научные положения; – делает выводы и обобщения; – владеет системой специализированных понятий.

Оценка компетенции	Характеристика сформированных компетенций
5-балльная шкала	
«удовлетворительно» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> – обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы; – допускает несущественные ошибки и неточности; – испытывает затруднения в практическом применении знаний направления; – слабо аргументирует научные положения; – затрудняется в формулировании выводов и обобщений; – частично владеет системой специализированных понятий.
«неудовлетворительно» «не зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> – обучающийся не усвоил значительной части программного материала; – допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении; – испытывает трудности в практическом применении знаний; – не может аргументировать научные положения; – не формулирует выводов и обобщений.

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы.

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Вопросы для экзамена

Перечень вопросов для экзамена		
Поверхностное натяжение. Смачивание, адгезия и капиллярные явления. Очистка подложек. Физические методы очистки. Очистка подложек. Химические методы очистки. Методы контроля чистоты подложки. Технологические атмосферы и среды. Параметры атмосферы. Герметичные скафандры. Диффузия. Уравнения Фика. Диффузия из постоянного источника. Диффузия из слоя конечной толщины. Диффузия из бесконечно тонкого слоя.	Диффузианты. Техническая реализация процессов диффузии. Ионное легирование. Аморфная мишень. Ионное легирование. Канальный эффект. Ионное легирование. Техническая реализация. Литография. Фотолитография. Фотолитография. Законы фотохимии. Светочувствительность. Разрешающая способность. Кислотостойкость. Технологический процесс фотолитографии. Методы изготовления фотошаблонов. Оптико-механический метод изготовления. Рентгенолитография. Рентгенорезисты. Рентгеношаблоны Электронолитография. Электронорезисты. Взаимодействие электронов с резистом Вакуум. Характеристики вакуума. Низкий, средний, высокий и сверхвысокий вакуум.	Вакуумные методы нанесения пленок. Термовакuumное испарение. Ионные методы нанесения. Катодное распыление. Коэффициент распыления Ионно-плазменное распыление. Магнетронное распыление Сварка плавлением. Сварка давлением. Пайка. Припой. Флюсы. Роль флюса в процессе пайки. Термокомпрессионная сварка Сварка расщепленным электродом. Сварка V-образным электродом. Ультразвуковая сварка. Сварка электронным и лазерным лучем.

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета	Код индикатора
	Учебным планом не предусмотрено	

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы

№ п/п	Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы
	Учебным планом не предусмотрено

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов

№ п/п	Примерный перечень вопросов для тестов	Код индикатора
	Не предусмотрено	

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обучения, представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Перечень контрольных работ

№ п/п	Перечень контрольных работ
	Не предусмотрено

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Конспект лекций в информационной системе кафедры

ТОКПЭ_Конспект

Методические указания для обучающихся по прохождению лабораторных работ МУ в информационной системе кафедры

ТОКПЭ_МУ по ЛР

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы

МУ в информационной системе кафедры

ТОКПЭ_МУ по СРС

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя:

– экзамен в 5 семестре – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять их для решения практических задач. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения	Содержание изменений и дополнений	Дата и № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой